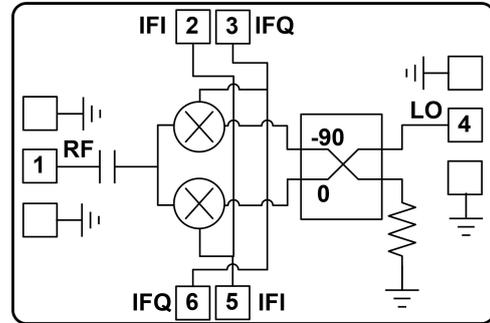




主要特点

- 无源式，不需要直流偏置
- 射频频率：5 – 13 GHz
- 中频带宽：DC – 4 GHz
- 转换损耗：9 dB
- LO/RF 隔离：55 dB
- 输入 P1dB: +17 dBm
- 芯片尺寸：2.0 × 2.2 × 0.1 mm³

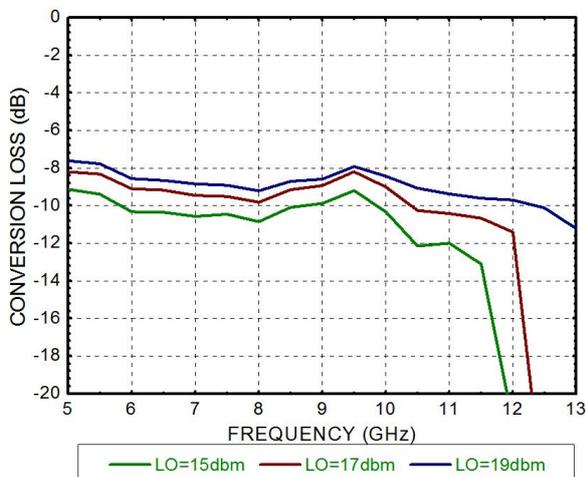
功能框图



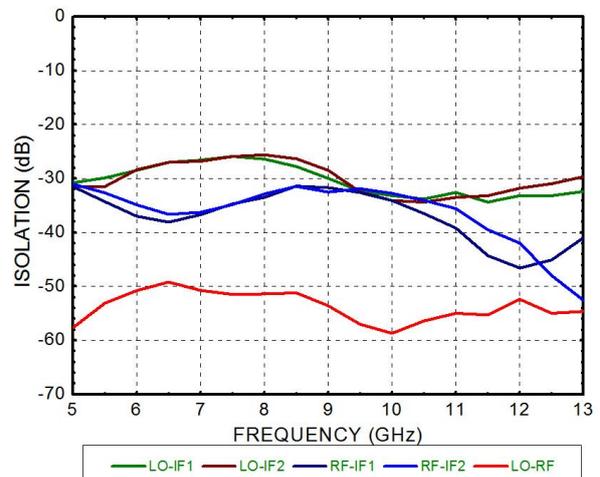
性能指标 ($T_A = +25^\circ C$, $IF = 100 MHz$, $LO = +19dBm$)

参数	最小	典型	最大	单位
射频/本振频率 (RF/LO)	5 – 13			GHz
中频频率 (IF)	DC – 4			GHz
变频损耗		9		dB
隔离度 “LO 至 RF”		55		dB
隔离度 “LO 至 IF”		30		dB
隔离度 “RF 至 IF”		35		dB
输入 1dB 压缩点功率		17		dBm

变频损耗 vs. 本振驱动

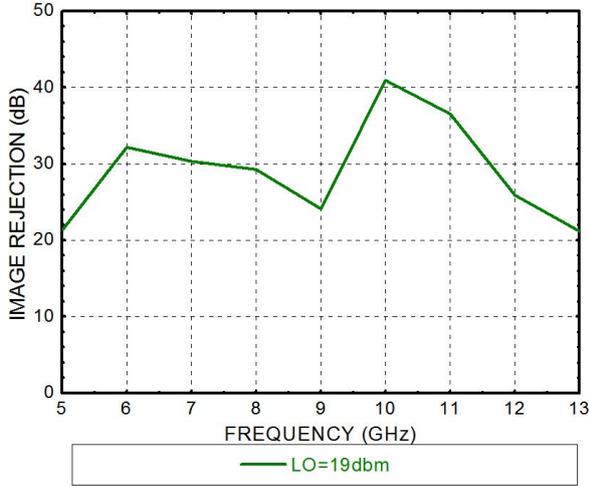


隔离度

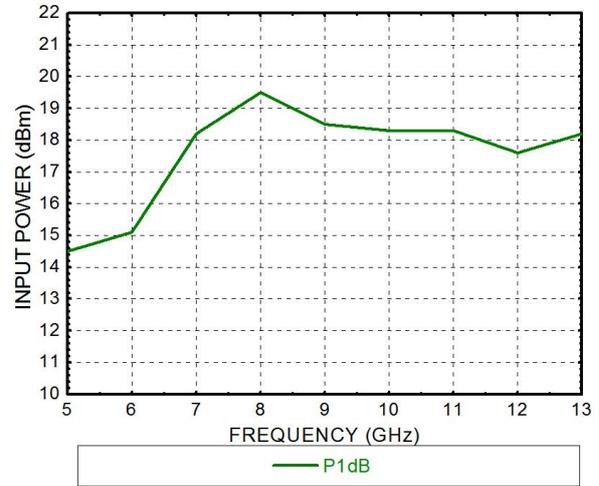




镜频抑制度

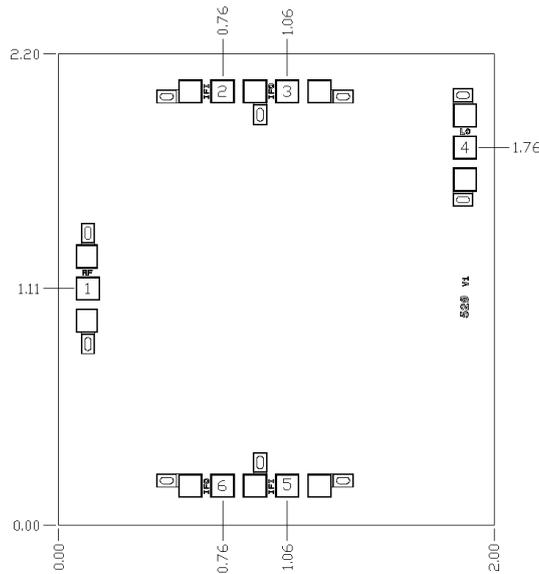


输入功率P1dB



物理参数

单位：毫米



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RF	射频端, 该焊盘是 AC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
2,5	IFI	同相端, 该焊盘是 DC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
3,6	IFQ	正交端, 该焊盘是 DC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
4	LO	本振端, 该焊盘是 AC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

极限参数

射频/中频输入功率: +20 dBm

储存温度: -65~+150°C

本振驱动功率: +27 dBm

工作温度: -55~+85°C